

ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

スタッキングフォールト（S F）核をシリコンウェーハの面内方向全体に分布させるとともに、前記スタッキングフォールト核の密度を、 $0.5 \times 10^8 \sim 1 \times 10^{11} \text{ cm}^{-3}$ の範囲に設定したシリコンウェーハを採用した。